سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
بررسی جریان نشت گیت در ترانزیستورهای اثر میدان با تحرک پدیری بالای الکترونی AlGaN/GaN

محل انتشار:
همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:
زهرا هاشم پور - *دکترا در رشته فیزیک و عضو هئا ت علمی واحد خوی*

رجب یحیی زاده - *دکترا در رشته فیزیک و عضو هئا ت علمی واحد خوی*

خلاصه مقاله:
دراین مدل تحلیلی تاثیر جریان نشت گیت برروی پارامترهای سیگنال کوچک مداربادرنظرگرفتن جریانهای سطحی , جریانهای حجمی ,جریانهای تونل زنی وجریان گسیل گرمایونی درترانزیستورهای اثرمیدان ساختارهای نامتجانس بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدباافزایش ولتاژگیت-سورس ظرفیت خازن بطورچشمگیری افزایش می یابدواین درصورتی است که پهنای ناحیه تهی کاهش یابد و با کاهش پهنای ناحیه تهی جریان نشت گیت نیز افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:
جریان نشت گیت، AlGaN/GaN ، پهنای ناحیه تهی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/60506